



## SiC n型 基板 標準仕様

グレード	Ultra	Production	Reserch	Dummy
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ			
面方位	(0001)±0.5° / (0001) off angle toward A-axis			
厚さ	350.0±25.0μm 500.0±25.0μm			
OF方位	<11-20>±0.5°			
IF方位	OFから時計回りに90°			
欠陥密度 (マイクロパイプ)	≦1/cm <sup>2</sup>	≦5/cm <sup>2</sup>	≦10/cm <sup>2</sup>	N/A
抵抗率	0.01~0.03Ωcm			0.01~0.03Ωcm(70%エリア)
TTV	≦10μm			≦15μm
Bow	≦10μm	≦20μm	≦25μm	N/A
面仕上げ	両面鏡面研磨、Si面CMP			
使用可能エリア	≧90%		≧80%	N/A

直径	(mm)	50.8±0.5	76.2±0.5	100.0±0.5
OF長さ	(mm)	16.0±2.0	22.0±2.0	32.5±2.0
IF長さ	(mm)	8.0±2.0	11.0±2.0	18.0±2.0



## SiC 半絶縁型 基板 標準仕様

グレード	Production	Reserch	Dummy
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ		
面方位	(0001)±0.5° / (0001) off angle toward A-axis		
厚さ	350.0±25.0μm 500.0±25.0μm		
OF方位	<11-20>±0.5°		
IF方位	OFから時計回りに90°		
欠陥密度 (マイクロパイプ)	≦5/cm <sup>2</sup>	≦10/cm <sup>2</sup>	≦50/cm <sup>2</sup>
抵抗率	≧1.0×10 <sup>7</sup> Ωcm		≧1.0×10 <sup>7</sup> Ωcm(70%エリア)
TTV	≦10μm		≦20μm
Bow	≦25μm		≦30μm
面仕上げ	両面鏡面研磨、Si面CMP		
使用可能エリア	≧90%	≧80%	N/A

直径	(mm)	50.8±0.5	76.2±0.5	100.0±0.5
OF長さ	(mm)	16.0±2.0	22.0±2.0	32.5±2.0
IF長さ	(mm)	8.0±2.0	11.0±2.0	18.0±2.0

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。